

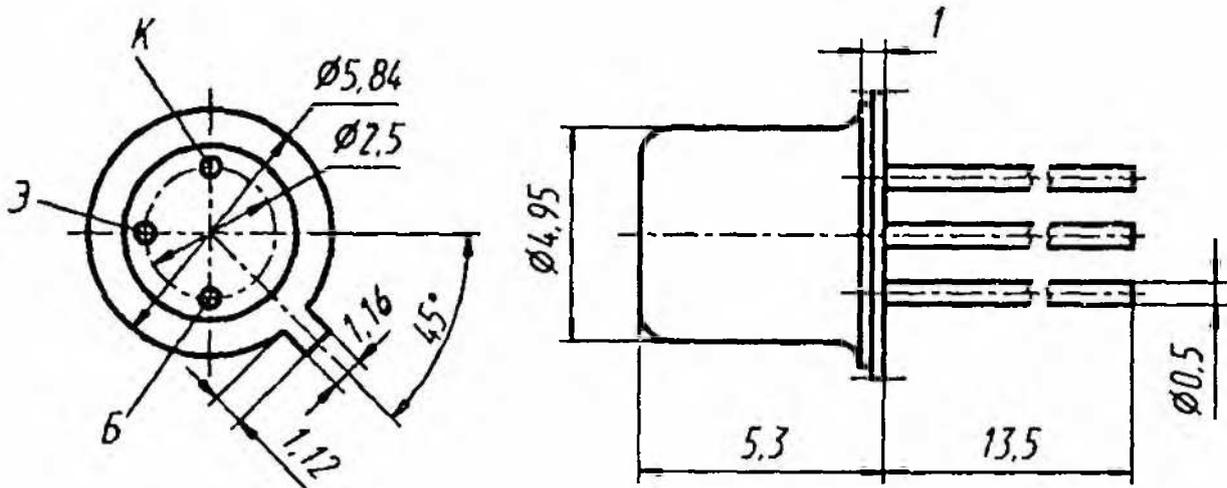
КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е, КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты, операционных, дифференциальных и импульсных усилителях, преобразователях. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,6 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

КТ501(А-М)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $U_{кз} = 1$ В, $I_k = 30$ мА:

КТ501А, КТ501Г, КТ501Ж, КТ501Л	20...60
КТ501Б, КТ501Д, КТ501И, КТ501М	40...120
КТ501В, КТ501Е, КТ501К	80...240

при $U_{кз} = 1$ В, $I_{к,и} = 0,5$ А, не менее

6

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 5$ В, $I_k = 10$ мА, не менее

5 МГц

Коэффициент шума при $U_{кб} = 3$ В, $I_k = 0,2$ мА, $R_T = 3$ кОм, $f = 1$ кГц, не более

4 дБ

типичное значение

2* дБ

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер,
не более:

при $I_K = 0,3 \text{ А}$, $I_B = 0,06 \text{ А}$	0,4 В
при $I_{K, И} = 0,5 \text{ А}$, $I_B = 0,1 \text{ А}$	0,7 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_K = 0,3 \text{ А}$, $I_B = 0,06 \text{ А}$, не более	1,5 В
--	-------

Обратный ток коллектор—эмиттер

при $U_{KЭР} = U_{KЭР, МАКС}$, $R_{БЭ} = 10 \text{ кОм}$, не более ...	1 мкА
--	-------

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = U_{БЭ, МАКС}$,

не более	1 мкА
----------------	-------

Емкость коллекторного перехода

при $U_{КБ} = 10 \text{ В}$, $f = 500 \text{ кГц}$, не более	50 пФ
--	-------

Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0,5 \text{ В}$,

$f = 500 \text{ кГц}$, не более	100* пФ
--	---------

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база

и коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ кОм}$,

$T = +25...+125 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ501А, КТ501Б, КТ501В	15 В
КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е	30 В
КТ501Ж, КТ501И, КТ501К	45 В
КТ501Л, КТ501М	60 В

Постоянное напряжение база—эмиттер:

при $T = -60...+125 \text{ }^\circ\text{C}$ для КТ501А, КТ501Б, КТ501В, КТ501Г, КТ501Д, КТ501Е	10 В
при $T = +25...+125 \text{ }^\circ\text{C}$ для КТ501Ж, КТ501И, КТ501К, КТ501Л, КТ501М	20 В

Постоянный ток коллектора

0,3 А

Импульсный ток коллектора

0,5 А

Постоянный ток базы

0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора при $T = -60...+35 \text{ }^\circ\text{C}$

0,35 Вт

Температура $p-n$ перехода

+150 $^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

-60...+125 $^\circ\text{C}$

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт присоединяется первым и отключается последним.

Расстояние от места сгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм с радиусом закругления 1,5...2 мм. Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора.